



Вячеславу Александровичу Харченко — 80 лет

Ведущему научному сотруднику отдела математического моделирования гетерогенных систем Федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук», доктору технических наук Харченко Вячеславу Александровичу исполнилось 80 лет.

Харченко Вячеслав Александрович родился 14 марта 1941 г. в г. Алма-Ата. В 1965 г. он закончил Московский институт стали и сплавов, в 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 1990 г. — на соискание ученой степени доктора технических наук. После окончания института с 1965 по 1987 гг. работал в филиале НИФХИ им. Л. Я. Карпова (г. Обнинск, Калужской обл.) в должностях младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, зав. лабораторией. С 1987 по 1991 гг. В. А. Харченко работал в должностях начальника техотдела ПХМЗ (Подольск), главного металлург НПО «РЕДМЕТ» (Москва). В 1991—1992 гг. он возглавлял НИИ Материаловедения (Зеленоград). С 1992 по 2000 гг. — директор ассоциации производителей и потребителей кремниевой продукции «СИЛИТЕХ», «Исследовательского центра проблем конверсии и экспертизы» — дочерней фирмы государственного фонда конверсии. С 2000 по 2006 гг. занимал должность заместителя директора по научной работе ФГУП «ГИРЕДМЕТ», с 2006 по 2015 гг. — руководителя отделения материалов и компонентов электронной



Российские ученые консультируют китайских специалистов по росту монокристаллов кремния

*Российские специалисты
обсуждают с директором
строящегося китайского завода
г-ом Ченом варианты генплана*

*Российские специалисты
осматривают земельный участок,
выделенный властями Китая
под строительство завода
полукристаллического кремния*



техники НТЦ радиоэлектронной борьбы, с 2015 г. ведущий научный сотрудник ВЦ РАН ФИЦ ИУ РАН.

Харченко В. А. является известным специалистом в области материаловедения полупроводников и структур на их основе. Сфера научных интересов Вячеслава Александровича — фундаментальные исследования физики реальных кристаллов, образование и взаимодействие дефектов структуры в процессах роста кристаллов и создания электронных структур, а также под воздействием внешних факторов, влияние дефектов на свойства полупроводниковых материалов и электрические параметры электронных компонентов. Им выполнен цикл фундаментальных и прикладных исследований воздействия ядерных излучений на свойства различных полупроводниковых материалов, которые позволили заложить научные основы нового направления — ядерного легирования полупроводниковых материалов. Научные исследования в этой области доведены им до стадии промышленного освоения, на различных ядерных реакторах, что позволило решить важную народнохозяйственную задачу —

обеспечение электронного приборостроения отечественным кремнием требуемого качества, заметно опередив США и Западные страны.

Глубокие научные знания и широкая эрудиция позволяли Харченко В. А. на различных этапах своей научной и производственной деятельности достаточно успешно решать проблемы развития полупроводниковой подотрасли и конверсии предприятий оборонных отраслей промышленности, возглавлять работы по научному сопровождению создания современных заводов полупроводникового кремния с замкнутым технологическим циклом.

В настоящее время им выполнен цикл исследований по обоснованию применения методов математического моделирования при решении проблем материаловедения полупроводников и гетероструктур, в том числе с наноразмерной топологией, опубликовано более 100 научных трудов, 20 авторских свидетельств и 7 патентов, издана монография.

Вячеслав Александрович более 15 лет читал лекции в МИСиС по спецкурсу. Он награжден правительственными наградами.

Редакция журнала «Известия вузов. Материалы электронной техники» поздравляет Вячеслава Александровича с Юбилеем, желает крепкого здоровья и новых творческих успехов.